

ТТЛШ(K555,SN74LS,DL,USI74LS.ШМ, K555ИР30

8-разрядный регистр хранения.

1	—	A0			Q0	—	4
2	—	A1			Q1	—	5
3	—	A2			Q2	—	6
					Q3	—	7
13	—	D			Q4	—	9
					Q5	—	10
15	—	R			Q6	—	11
14	—	E			Q7	—	12

№ выв.	Назначение	№ выв.	Назначение
1	Адресный вход	9	Выход 4 разряда
2	Адресный вход	10	Выход 5 разряда
3	Адресный вход	11	Выход 6 разряда
4	Выход 0 разряда	12	Выход 7 разряда
5	Выход 1 разряда	13	Вход информаци- онный
6	Выход 2 разряда	14	Вход разрешения
7	Выход 3 разряда	15	Вход установки в "0"
8	Общий	16	Ucc

Таблица истинности.

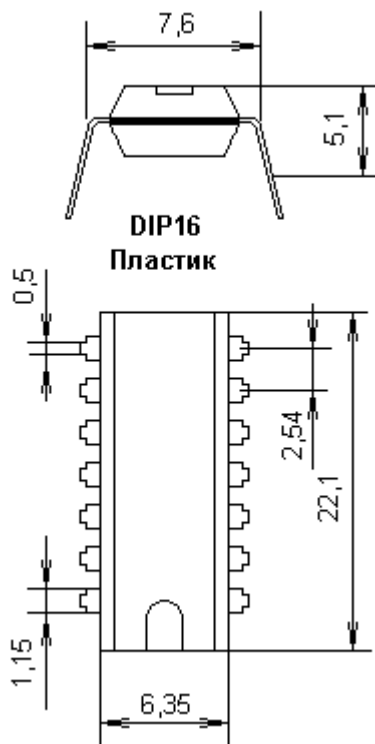
ВХОДЫ		Выход адресуемого	Выходы неадресуемых	Выполняемая
R	E	триггера	триггеров	функция
H	L	D	Q ₀	адресация
H	H	Q ₀	Q ₀	хранение
L	L	D	L	8-разрядный демультиплексор
L	H	L	L	очистка

Таблица выборки триггера.

Входы			Выбранный триггер
адресации			
A0	A1	A2	
L	L	L	0
L	L	H	1
L	H	L	2
L	H	H	3
H	L	L	4
H	L	H	5
H	H	L	6
H	H	H	7

Микросхема представляет собой восьмиразрядный регистр хранения с адресацией и широко используется в цифровых схемах в качестве рабочего регистра, дешифратора 3 на 8 или демультиплексора 1 на 8. Двоичный код на входах A0, A1, A2 определяет какой из восьми внутренних триггеров будет принимать информацию. Режимы работы регистра определяются логическим состоянием на входах R и E. В режиме адресации данные со входа D записываются в адресуемый триггер регистра и передаются на выход. Остальные разряды регистра хранят предыдущую информацию. В режиме хранения все триггеры хранят предыдущую информацию вне зависимости от логического состояния на входах D, A0, A1, A2.

Для исключения возможных сбоев триггеров на входе разрешения записи должно быть напряжение высокого уровня при изменении состояния адресных входов. В режиме дешифрации/демультиплексирования на адресуемый вход приходит информация со входа D, остальные выходы находятся в состоянии низкого уровня. И, наконец, в режиме сброса все выходы устанавливаются в состоянии низкого уровня.



Тип микросхемы	К555ИР30
Фирма производитель	СНГ
Функциональные особенности	8-разрядный регистр хранения с адресацией
Т,С	0...+70
I _{сс} ,мА	36
ТрНЛ max,нс	35
ТрЛН max,нс	48
Корпус	DIP16